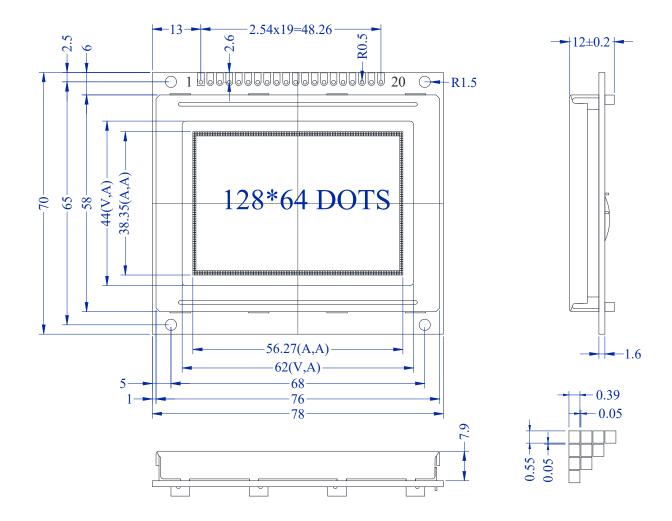
一、模块尺寸



项目	参考值
LCM 尺寸(长×宽×厚)	$78.0 \times 70.0 \times 12.0$
可视区域(长×宽)	62. 0×44. 0
点间距(长×宽)	0.44×0.60
点尺寸 (长×宽)	0.39×0.55

二、功能介绍

- ◆ 工作电压 3.3V 或者 5.0V (默认出厂为 5.0V)
- ◆ 提供三种与 MPU 通讯方式: 4 位、8 位并行, 串行通讯 (默认出厂未固定, 用户自己控制 PSB 来选择)
- ◆ 48x16bit 的字符显示 RAM (LCD 最多为 4 行 8 字)
- ◆ 64x128bit 的绘图 RAM (GDRAM)
- ◆ 2M bit 的中文字库 ROM (CGROM), 总共有 8192 个中文字型
- ◆ 16K bit 的半宽字型 ROW (HCGROM),总共有 126 个字母符号字形
- ◆ 64x16 bit 的自定义字符 RAM (CGRAM)
- ◆ 自动上电复位功能
- ◆ 外置复位端 (XRESET)
- ◆ 低功率省电设计(除背光 45MA)
 - 正常模式 (450uA typ VDD=5V)
 - 待机模式 (30uA max VDD=5V)
- ◆ 显示驱动电压 VLCD (VO~VSS): 最大 7V
- ◆ 绘图以及文字画面混合显示功能
- ♦ 多功能指令:
 - 画面清除 (display clear) 显示移位 (display shift)
 - 光标归零 (display clear) 垂直画面旋转 (vertical line scroll)
 - 显示开/关(display on/off) 反白显示(by_line reverse display)
 - 光标显示/隐藏 (cursor on/off) 待机模式 (standby mode)
 - 显示字闪烁 (display character blink)
 - 光标移位 (cursor shift)
- ◆ 占空比 1/32 偏压比 1/6
- ◆ 最佳可视角为 6点钟, 可以更改
- ◆ 显示颜色效果选黄绿,蓝白,灰白,也可以定制
- ◆ 工作温度, 宽温:-20 度到+70 度

三.接口定义

引脚	名称	方向	说明
1	VSS		电源负端(OV)
2	VDD		电源正端(+3.3V 或+5.0V, 默认出厂时设定+5.0V)
3	VO		LCD 驱动电压(可调)
4	RS (CS)	Ι	并口方式: ● RS=0: 当 MPU 进行读模块操作,指向地址计数器。 当 MPU 进行写模块操作,指向指令寄存器。 ● RS=1: 无论 MPU 读/写操作,均指向数据寄存器。 串口方式: CS: 串行片选信号,高电平有效。
5	R/W(SID)	I	并口方式: ● R/W=0 写操作。● R/W=1 读操作。串口方式:SID: 串行数据输入端
6	E (SCLK)	Ι	并口方式: 使能信号, 高电平有效。 串口方式: SCLK 串行时钟信号。
7-14	DB0 ~ DB7	I/0	MPU 与模块之间并口的数据传送通道, 4 位总线模式下 $D0^{-0}$ $D3$ 脚断开
15	PSB	Ι	串/并口控制选择端: (内部 J2 也可选择)
16	NC	Ι	空脚
17	RST	Ι	复位脚(低电平有效)
18	VOUT		倍压输出脚。(VDD=+3.3V 时有效)
19	LEDA		背光电源正端(+3.3V 或+5.0V, 出厂时设定+5.0V)
20	LEDK		背光电源负端(0V)

四. 电性参数(直流)

名称	符号	湖北夕州		参数范围		的石
石 小	付与	测试条件	最小	标准	最大	单位
模块工作电压	VDD	_	4. 5/3. 1	5. 0/3. 3	5. 5/3. 5	V
玻璃电压	VO	VO-VDD	4. 5	5. 0	7. 0	V
背光工作电压	VLED	_	4.5/3.1	5.0/3.3	5.5/3.5	V
IO 输入高电平	VIH	_	0. 7VDD	_	VDD	V
IO 输入低电平	VIL	_	_	_	0.6	V
LCM 输出高电平	VOH	_	0.8VDD	_	_	V
LCM 输出低电平	VOL	_	-	-	0.4	V
模块工作电流	IDD	=VDD	_	_	0. 5	MA
模块待机电流	IDO	=VDD	_	_	10	uA
背光工作电流	ILED	=VLED	30	45	60	MA

五.显示原理

DDRAM 地址与 128*64 点阵显示屏的关系(可以显示 8*4=32 个汉字)一行最多 16 字表 1

-//- 1	•																
7	Y								128	点							
7	X	Н	L	Н	L	Н	L	Н	L	Н	L	H L		Н	L	Н	L
上	32	8	80	81		82		8	83		84		5	86		87	
半屏	点	9	00	91		92		9	3	9	4	9	5	9	6	9	7
下	32	8	88	89		8	SA	8B		8C		8D		8E		8	F
半屏	点	9	18	99		9	A	9B		9C		9D		D 9E		9	F

80 表示 DDRAM 地址,80 代表一个显示汉字的地址,占 16*16 点阵,只要在80 地址内写入汉字内码就能显示你的汉字或者字符,汉字内码有两个字节,高位(H)写在前,低位(L)写在后,注意地址会自动加1。

现在的单片机编译软件都能引用汉字编译出汉字内码,12864有一套标准的GB2312简体字库,收到汉字内码直接调取内部对应点阵显示在屏幕上。

12864 屏实际上是将一个 25632 点阵屏中间切断,左边的一半 12832 放在上半屏,右边的一半 12832 放在下半屏,组成的 12864 点阵屏,用户在编程的时候要特别注意。

GDRAM 与 12864 点阵的关系(128*64 点阵的绘图像素)

表 2

V	上								128	点							
	点点	Н	L	Н	L	Н	L	Н	L	Н	L	Н	L	Н	L	Н	L
Λ	灬	()]	L	4	2	3	}	4		5		6		7	
	0	Y0	XO	YOX1		Y0	Х2	YO	Х3	Y0	X4	YOX5		YOX6		Y0	Х7
上	1	Y1	Х0	Y1X1		Y1X2		Y1X3		Y1X4		Y1X5		Y1X6		Y1	Х7
半	2	Y2	Х0	Y2X1		Y2X2		Y2	Х3	Y2X4		Y2	Х5	Y2X6		Y2	Х7
屏	``	``	`	>>>		***		***		,	`	``	`	***		``	`
	31	Y31	LX0	Y31	1X1	Y31X2		Y31X3		Y31	X4	Y31	X5	Y31	IX6	Y31	1X7
	0	Y0	Х8	YO	Х9	YOX	Κ10	Y0X11		Y0X12		Y0X13		Y0X14		YOX15	
下	1	Y1	Х8	Y1	Х9	YO	110	Y1>	X11	Y1X12		Y1X13		Y1X14		.4 Y1X	
半	2	Y1	Х8	Y1X9		Y12	K10	Y1>	X11	Υ1Σ	(12	Υ1Σ	(13	Y12	Κ14	Y12	X15
屏	``	``	,	***		***		```	***		***		***		***		`
	31	Y31	LX8	Y31X9		Y31	X10	Y31X11		Y31X12		Y31X13		Y31X14		Y31	X15

Y 为列的位置, X 是水平上的地址(水平一个地址有16个点)

位=点	D15	D14	D13	D12	D11	D10	D9	D8	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0
字节	Н										I	,				
地址)h							

GDRAM 与 12864 点阵的分布图,程序写入过程为,先写入垂直地址,例如 (0-31),再写水平 X 地址,例如; (0-7/8-15),一个水平地址有 1*16 位点阵(分两字节,先写高字节,再写低字节,高位在左边),水平地址可以自动加 1,

这里 0 地址看作 0X80, 在写地址的时候都要加上 0X80; 举例, 如果是在第 2 行的第 33 列, 垂直地址为 0x80+1, 水平地址为 0x80+2,

要调一幅图片时,使用横向取模取出点阵数据, 你也可以自编图形, 在最后的程序例程中,有绘制边框供你参考

写显示数据流程



a) CGRAM

自编字符 CGRAM

字符预留了几个自编字符空间,编写一些特殊的字符或者符号,使用原理,进入 CGRAM (40H);选择内码地址 02 (00 到 08);然后写入 8*8 点阵数据(横向取模), 要显示自编字符时,写显示 DDRAM 地址,然后写入内码地址 02 就能显示自编符号啦

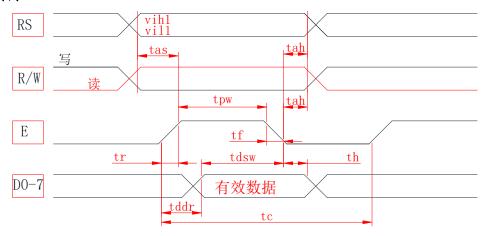
b) HCGROM

内部的字符

	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	A	В	C	D	E	F
00		☺	8	٠	*	Φ	÷	•	÷	0	0	δ	Ŷ	ŗ	Ŋ	*
10	F	4	‡	!!	q	δ	_	‡	t	ţ	→	+	_	++	•	₹
20		•	• •	#	\$	×	&	•	()	×	+	,	_	•	/
30	0	1	2	3	4	5	6	7	8	9	•		<	=	>	?
40	6	A	В	С	D	E	F	G	Н	Ι	J	K	L	M	N	0
50	P	Q	R	S	T	U	V	М	X	Y	Z	E	\]	^	
60	•	a	Ь	C	d	е	f	g	h	i	j	k	1	m	n	o
70	p	q	r	S	t	u	V	W	×	y	z	€	ł	}	~	Δ

六. 时序图

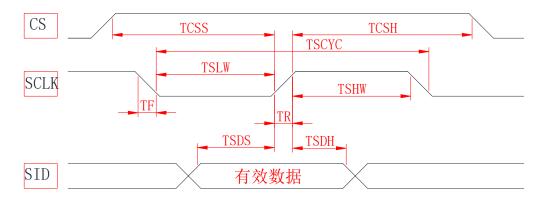
并口时序



并口模式常温(环境25度, VDD=4.5V 或者 VDD=2.7V)

参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位
		内部时钟				•
振荡频率	Fosc	R=33kr/R=18kr	480/470	540/530	600/590	Khz
		外部时钟				
外部频率	fex	_	480/470	540/530	600/590	Khz
占空比			45	50	55	%
上升/下降时间	Tr,tf	_	_	_	0.2	us
	写	模式(从单片机写数	枚据到模块)			
E周期	Тс	Е	1200/1800	_	_	Ns
E脉冲宽度	Tpw	Е	140/160	_	_	Ns
E上升/下降时间	Tr,tf	Е	_	_	25	Ns
地址建立时间	Tas	Rs,r/w,e	10	-	-	Ns
地址保持时间	Tah	Rs,r/w,e	20	-	-	Ns
数据建立时间	Tdsw	D0-d7	40	-	-	Ns
数据保持时间	Th	D0-d7	20	-	-	Ns
	读	模式(从模块读数据	居到单片机)			
E周期	Тс	Е	1200/1800	_	_	Ns
E脉冲宽度	Tpw	Е	140/320	-	-	Ns
E上升/下降时间	Tr,tf	Е	-	-	25	Ns
地址建立时间	Tas	Rs,r/w,e	10	-	_	Ns
地址保持时间	Tah	Rs,r/w,e	20	-	-	Ns
数据建立时间	Tddr	D0-d7	-	-	100/260	Ns
数据保持时间	Th	D0-d7	20	-	_	Ns

串口时序



串口模式常温(环境25度, VDD=4.5V 或者 VDD=2.7V)

于 中 沃 江 加 一 ()		7 1.5 V 3A V DD	<u> </u>								
参数	符号	测试条件	最小	典型	最大	单位					
		内部时钟									
振荡频率	Fosc	R=33kr/R=18kr	470	530	590	Khz					
		外部时钟									
外部频率	fex	_	470	530	590	Khz					
占空比			45	50	55	%					
上升/下降时间	Tr,tf	_	-	-	0. 2	us					
写模式(从单片机写数据到模块)											
串行时钟周期	TSCYC	E/SCLK	400/600	-	_	Ns					
SCLK高脉宽	TSHW	E/SCLK	200/300	-	-	Ns					
SCLK脉宽	TSLW	E/SCLK	200/300	-	-	Ns					
SID数据建立时间	TSDS	RW/SID	40	-	-	Ns					
SID数据保持时间	TSDH	RW/SID	40	-	-	Ns					
CS建立时间	TCSS	RS/CS	60	_	_	Ns					
CS保持时间	TCSH	RS/CS	60	_	_	Ns					

七. 指令说明

1、**指令表:** (RE=0: 基本指令集)

1 18 7			E-0:		1日 マ								执行时间
指令	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX	说明	(540KHZ
清除显示	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0X01	将DDRAM填满"20H",并 且设定DDRAM的地址计数 器(AC)到"00H"	1.6ms
地址归零	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	0X02	设定DDRAM的地址计数器 (AC)到"00H",并且将 光标移到开头原点位置, 这个指令并不改变DDRAM 的内容	72us
输入点设定	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	0X4X	指定在数据的读取与写入 时,设定光标的移动方向 及指定显示的移位	72us
显示状态 开/关	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	0x8x	D=1; 整体显示ON C=1; 光标ON B=1; 光标位置反白ON	72us
光标或显 示移位控 制	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X	0x1x	设定光标的移动与显示的 移位控制位;这个指令并 不改变DDRAM的内容	72us
功能设定	0	0	0	0	1	DL	X	ORE	X	X	0X2X	DL=1; 8位控制模式 DL=0; 4位控制模式 RE=1; 选择扩展指令集 RE=0; 选择基本指令集	72us
设定CGRAM 地址	0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	ACO	0X4X	设定CGRAM地址到地址计数器(AC)需确认扩展指令中SR=0(卷动地址或RAM地址选择	72us
设定DDRAM 地址	0	0	1	OAC 6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	0X8X	设定CGRAM地址到地址计 数器 (AC) AC6固定为0	72us
读取忙碌 标志 (BF) 和地址	0	1	BF	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	ACO		读取忙碌标志 (BF) 可以确认内部动作是否完成,同时可以读出地址计数器(AC)的值	0us
写数据到 RAM	1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		写入数据到内部RAM (DDRAM/CGRAM/GDRAM)	72us

绘晶科技 12864K 液晶显示模块说明书

第 11 页 共 31 页

读出RAM的			5.5	D.C.	5.5	-	D.O.	D.O.	D.1	20	从内部RAM读取数据	72us
数据	1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	(DDRAM/CGRAM/GDRAM)	

指令表二: (RE=1: 扩充指令集)

指令					指名	→ 今码					HEX	说明	执行时间 (540KHZ)
	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO			
待机模式	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0X01	进入待机模式,执行任何 其它指令都可终止待机 模式(COM1~32停止动作)	72us
卷动地址 或RAM地 址选择	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SR	0X02	SR=1;允许输入垂直卷动 地址SR=0;允许设定 CGRAM地址(基本指令)	72us
反白选择	0	0	0	0	0	0	0	1	R1	RO	0X4X	选择4行中的任一行反白显示,并可决定反白与否R1,R0初什为'00,当第一次设定时为反白显示,再一次设定时为正常显示	72us
扩充功能设定	0	0	0	0	1	DL	X	1RE	G	0	0X3X	DL=1; 8位控制模式 DL=0; 4位控制模式 RE=1; 选择扩展指令集 RE=0; 选择基本指令集 G=1; 绘图显示ON G=0; 绘图显示OFF	72us
设定IRAM 地址或卷 动地址	0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC	AC0	0X4X	SR=1: AC5~AC0为垂直卷 动地址	72us
设定绘图 RAM地址	0	0	1	00	0AC5	0AC 4	AC3	AC2 AC2	AC 1A C1	ACO ACO	0X8X	设定(GDRAM地址到地址 计数器(AC) 先设垂直地址再设水平 地址(连续写入两个字节 的坐标地址) 垂直地址范围AC5~AC0 水平地址范围AC3~AC0	2us

2、具体指令介绍:

基本指令(RE=0)

1) 清除显示:

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX	
代码	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0x01	

功能: 将DDRAM 填满"20H"(空格), 把DDRAM 地址计数器调整"00H", 重新进入 点设定将I/D设为"1", 光标右移AC 加1。

2) 地址归位:

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	HEX
代码	0	0	0	0	0	0	0	0	1	X	0x02

功能:把DDRAM 地址计数器调整为"OOH",光标回原点,该功能不影响显示DDRAM

3) 输入点设置:

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	HEX	
代码	0	0	0	0	0	0	0	1	I/D	S	0x04	

功能: 设定光标移动方向并指定整体显示是否移动。

I/D=1 光标右移, AC自动加1: I/D=0 光标左移, AC自动减1。

S=1 且DDRAM为写状态:整体显示移动,方向由I/D决定(I/D=1左移,I/D=0 右移)

S=0 或DDRAM 为读状态:整体显示不移动.

4) 显示状态开/关:

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX	
代码	0	0	0	0	0	0	1	D	С	В	0x08	

功能: D=1: 整体显示ON: D=0: 整体显示OFF。

C=1: 光标显示ON; C=0: 光标显示OFF。

B=1: 光标位置反白且闪烁; B=0: 光标位置不反白闪烁。

5) 光标或显示移位控制:

绘晶科技 12864K 液晶显示模块说明书

第 13 页 共 31 页

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX
代码	0	0	0	0	0	1	S/C	R/L	X	X	0x1x

功能: S/C: 光标左/右移动, AC减/加1。

R/L: 整体显示左/右移动, 光标跟随移动, AC值不变。

S/C	R/L	说明	AC值
L	L	光标向左移动	AC=AC-1
L	Н	光标向右移动	AC=AC+1
Н	L	显示向左移动, 且光标跟着移动	AC=AC
Н	Н	显示向右移动, 且光标跟着移动	AC=AC

6) 功能设定:

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	HEX	
代码	0	0	0	0	1	DL	X	RE	X	X	0x2x	

功能: DL=1: 8-BIT 控制接口: DL=0: 4-BIT 控制接口。

RE=1: 扩充指令集动作; RE=0: 基本指令集动作。

7) 设定CGRAM地址:

	RS	RW				D4				D 0	HEX	
代码	0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	0x4x	

功能:设定CGRAM地址到地址计数器(AC),需确定扩充指令中SR=0(卷动地 址或RAM地址选择)

8) 设定DDRAM地址:

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO		HEX
代码	0	0	1	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0		0x8x
	功能:	设定D	DRAM地	b 址到5	也址计	数器 (AC)				'	

9) 读取忙碌状态 (BF) 和地址:

				D6							HEX	
代码	0	1	BF	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	0xXx	

功能: 读取忙碌状态 (BF) 可以确认内部动作是否完成, 同时可以读出地址 计数器 (AC) 的值, 当BF=1, 表示内部忙碌中此时不可下指令需等BF=0 才可下新指令

10) 写资料到RAM:

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		HEX
代码	1	0	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0		0xXx
马	力能:	写入资	料到内	部的R	AM (DI	ORAM/C	GRAM/0	GDRAM)	, 每	个RAM地	山山	上都要连
续写。	入两个	字节的	7资料。									

11) 读RAM的值:

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX
代码	1	1	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	0xXx

功能: 从内部RAM 读取数据(DDRAM/CGRAM/GDRAM), 当设定地址 指令 后,若需读取数据时需先执行一次空的读数据,才会读取到正确数据, 第二 次读取时则不需要,除非又下设定地址指令。

扩充指令(RE=1)

1) 待命模式:

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	HEX	
代码	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0x1x	

功能: 进入待命模式, 执行其它命令都可终止待命模式

2) 卷动地址或RAM地址选:

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX	
代码	0	0	0	0	0	0	0	0	1	SR	0x2x	

功能: SR=1: 允许输入卷动地址;

SR=0: 允许设定CGRAM地址(基本指令)

3) 反白选择:

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	HEX	
代码	0	0	0	0	0	0	0	1	R1	R0	0x4x	

功能: 选择2 行中的任一行作反白显示,并可决定反白与否。第一次设定为 反白显示, 再次设定时为正常显示

12864	R1	RO	行地址参数
豆	L	L	第一、三、行反白或正常显示
屏	L	Н	第二、四、行反白或正常显示

4) 睡眠模式:

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX
代码	0	0	0	0	0	0	1	SL	X	X	0x08

功能: SL=1: 脱离睡眠模式; SL=0: 进入睡眠模式。

5) 扩充功能设定:

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX	
代码	0	0	0	0	1	DL	X	RE	G	X	0x3x	

功能: DL=1: 8-BIT 控制接口; DL=0: 4-BIT 控制接口

RE=1: 扩充指令集动作; RE=0: 基本指令集动作

G=1: 绘图显示0N: G=0: 绘图显示0FF

6) 卷动地址设定:

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	DO	HEX	
代码	0	0	0	1	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	0x4x	

功能: SR=1, AC5~AC0 为垂直卷动地址

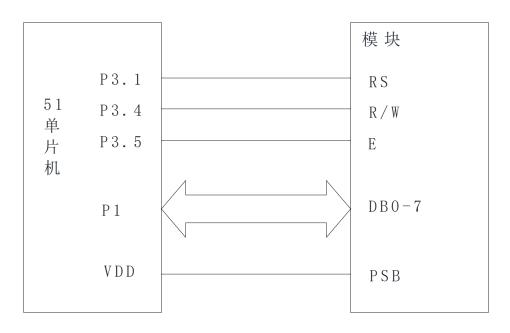
7) 绘图RAM地址设定:

	RS	RW	D7	D6	D5	D4	D3	D2	D1	D0	HEX	
代码	0	0	1	AC6	AC5	AC4	AC3	AC2	AC1	AC0	0x8x	

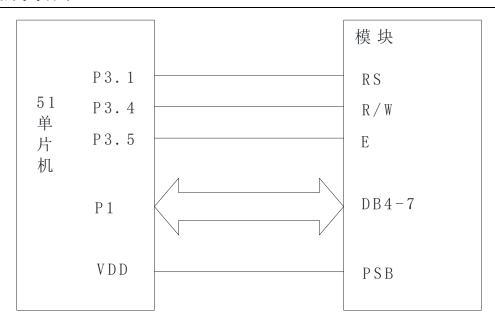
功能:设定GDRAM地址到地址计数器(AC)

八、单片机接线图

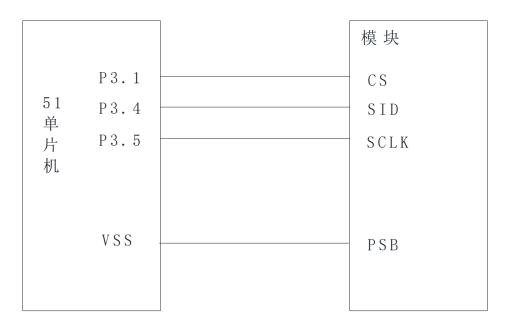
1)、8位并行接口:



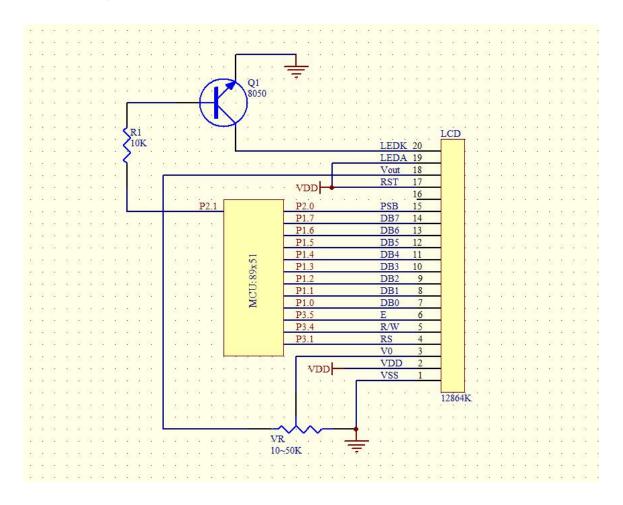
2)、4位并行接口:



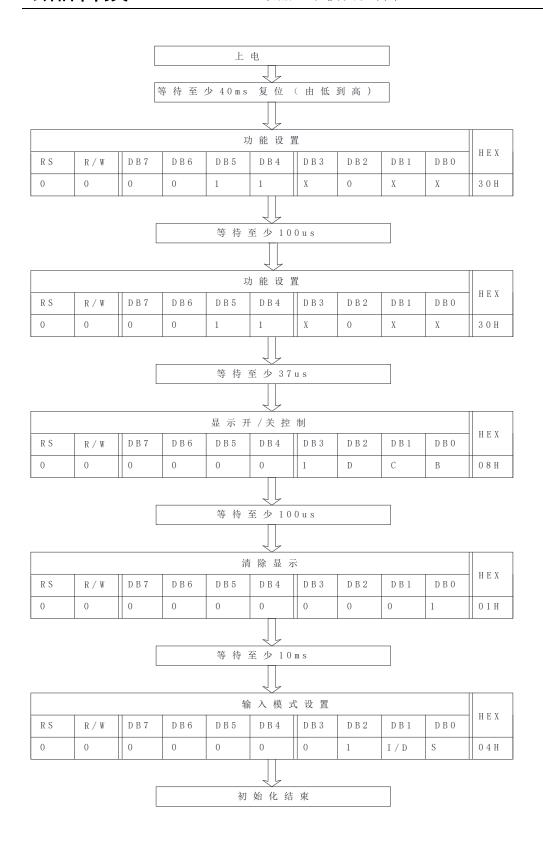
3)、串行接口:



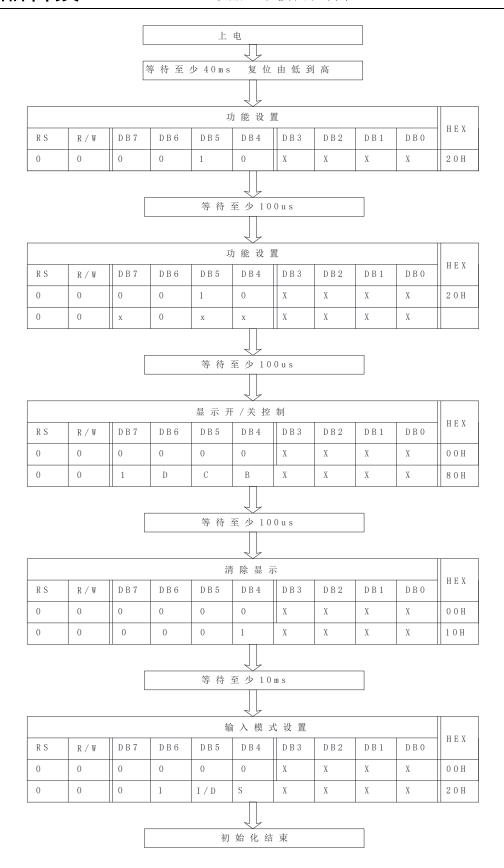
开发详细的接线方法



8位接口模式



4位接口模式



十、程序例程

```
//深圳绘晶科技有限公司、
//12864点阵中文字库,单片机:89S52, 晶振:12M,
//STC单片机完全兼容
//串并行共用程序
#include<reg52.h>
#include <intrins.h>
//sbit REST=P2^1;
sbit RS=P3<sup>1</sup>;//串口时为CS
sbit RW=P3<sup>4</sup>; //串口为SID
sbit E1=P3<sup>5</sup>; //串口为时钟SCLK
sbit PSB=P2<sup>0</sup>;//并口时, PSB=1;串口时, PSB=0
sbit stop=P3^2;//低电平触发
typedef unsigned int Uint;
typedef unsigned char Uchar;
Uchar z, z1, d, d1, s, s1, s10, s100, m1;
//汉字,直接可以写入字形,写入标点符号后要加空格键
unsigned char code uctech[] = {"绘晶科技公司地址区石岩镇麻布第二"};
//显示在第1,3行
unsigned char code uctech3[] = {"广东省深圳市宝安工业区第4 栋2 楼"};
//显示在第2,4行
unsigned char code uctech6[] = {"汇
                                                        至"};
                                          精焦
                                               128*64
//显示在第1,3行
unsigned char code uctech7[] = {"聚 绘晶科技 品点 23146001 上"};
//显示在第2,4行
unsigned char code uctech1[] = {"绘晶科技"};
//显示在第2行
unsigned char code uctech2[] = \{"128*64"\};
//显示在第3行
unsigned char code uctech4[] = {"TIME"};
unsigned char code uctech5[] = {"绘晶科技23146001"};
unsigned char code uctech8[] = {"有8192个中文字型"};
unsigned char code uctech9[] = {"有126 个字母符号"};
//这个是在串口时指令和数据之间的延时
void delay10US(Uchar x)
  Uchar k;
 for (k=0; k \le x; k++);
```

```
*/
const Uchar delay=250; //延时时间常数
static void Wait1ms(void)//延迟1 ms
 Uchar cnt=0;
 while (cnt<delay) cnt++;
}
//延迟n ms
void WaitNms(int n)
  Uchar i;
  for (i=1; i \le n; i++)
   Wait1ms();
//以下是并口时才开的
//读忙标志,
void RDBF(void)
   Uchar temp;
   RS=0; // RS=0
   RW=1; // RW=1
   while(1)
   P1=0xFF; //数据线为输入
   E1=1;
   temp=P1;
   E1=0; // E=0
   if ((temp&0x80)==0) break;
//写数据到指令寄存器
void WRCommandH(Uchar comm)
   RDBF();
   RS=0;
   RW=0;
   P1=comm;
   E1=1;
   E1=0;
```

```
//写数据到数据寄存器
void WRDataH(Uchar TEMP)
   {
m RDBF}\left( \right);
   RS=1;
   RW=0;
   P1=TEMP;
   E1=1;
   E1=0;
//以下是串口时开的读写时序
/*
void SendByteLCDH(Uchar WLCDData)
Uchar i;
for (i=0; i<8; i++)
if((WLCDData<<i)&0x80)RW=1;
else RW=0;
E1=0;
E1=1;
}
SPIWH (Uchar Wdata, Uchar WRS)
 {
  SendByteLCDH(0xf8+(WRS<<1));//寄存器选择WRS
  SendByteLCDH(Wdata&0xf0);
  SendByteLCDH((Wdata<<4)&0xf0);</pre>
}
void WRCommandH(Uchar CMD)
 RS=0;
 RS=1;
 SPIWH (CMD, 0);
 delay10US(90);//89S52来模拟串行通信,所以,加上89S52的延时,
```

```
void WRDataH(Uchar Data)
 RS=0;
 RS=1;
 SPIWH(Data, 1);
*/
//初始化LCD-8位接口
void LCDInit(void)
{ //PSB=0; //串口
   PSB=1; //并口时选这个, 上一行取消
// REST=1;
//
    REST=0;
    REST=1;
   WRCommandH(0x30);
                   //基本指令集,8位并行
                 //启始点设定: 光标右移
   WRCommandH (0x06);
   WRCommandH(0x01);
                   //清除显示DDRAM
   WRCommandH (0x0C);
                   //显示状态开关:整体显示开,光标显示关,光标显示反白关
   WRCommandH(0x02);
                   //地址归零
}
//addr为汉字显示位置,*hanzi汉字指针;count为输入汉字串字符数
void ShowQQCharH(Uchar addr,Uchar *hanzi,Uchar count)
   Uchar i;
                 //设定DDRAM地址
   WRCommandH(addr);
   for(i=0;i<count;)</pre>
      WRDataH(hanzi[i*2]);
      WRDataH(hanzi[i*2+1]);
      i++;
   }
//addr为半宽字符首个地址,i为首个半宽字符代码,count为需要输入字符个数
void ShowNUMCharH(Uchar addr, Uchar i, Uchar count)
```

```
Uchar j;
   for (j=0; j < count;)
      WRCommandH(addr); //设定DDRAM地址
      WRDataH(i+j);//必为两个16*8位字符拼成一个16*16才能显示
      j++;
      WRDataH(i+j);
      addr++;
      j++;
   }
//自定义字符写入CGRAM
//datal是高八位,data2是低八位,一存必须存两个字节,横向存两字节,后纵向累加,共16行
//一个自定义字符为16*16点阵
//第一个存入字节为从40H开始,到4F结束为第一个自定义汉字符,之后调出地址从8000H为始第一
//addr为存入头地址
void WRCGRAMH (Uchar data1, Uchar data2, Uchar addr)
    Uchar i;
    for (i=0; i<16;)
 {
    WRCommandH(addr+i);
                      //设定CGRAM地址
    WRDataH(data1);
    WRDataH(data1);
    i++;
                      //设定CGRAM地址
    WRCommandH(addr+i);
    WRDataH(data2);
    WRDataH(data2);
    i++;
 }
//自定义字符写入CGRAM
//显示上半屏自定义的字符,并把这个字符填满全屏16*16
//addr为显示地址,把自定义字符当一个汉字调出,从8000H开始为第一个,
//8100H为第二个,8200H为第三个,8300H为第四个,中文字库只能自定义四个字符
//i为自定义字符调出地址,先输入低位,再输入高位
//IC决定,中文字库类,一个IC最多只能显示16*2个汉字
void ShowCGCharH(Uchar addr,Uchar i)
   Uchar j;
   for (j=0; j<0x20;)
```

```
WRCommandH(addr+j); //设定DDRAM地址
       WRDataH(0x00)://字符地址低八位
       WRDataH(i);//字符地址高八位
       j++;
   }
void WRGDRAM128X8(Uchar x1,Uchar y1,Uchar d1 )
  Uchar j,i;
                              //去扩展指令寄存器
      WRCommandH (0x34);
      WRCommandH (0x36);
                              //打开绘图功能
      for(j=0; j<16; j++)
                                 //
              WRCommandH(0x80+y1+j); //Y总坐标,即第几行
              WRCommandH(0x80+x1); //X坐标,即横数第几个字节开始写起,80H为第一个字
节
              for(i=0; i<8; i++) //写入一行
              WRDataH(d1);
              WRDataH(d1);
         }
//上半屏清除图形区数据
void CLEARGDRAMH(Uchar c)
      Uchar j;
      Uchar i;
      WRCommandH (0x34);
      WRCommandH (0x36);
      for (j=0; j<32; j++)
         {
              WRCommandH(0x80+j);
              WRCommandH(0x80);//X坐标
              for(i=0; i<16; i++)//
              WRDataH(c);
              WRDataH(c);
          }
```

```
void WRGDRAM1(Uchar x, Uchar 1, Uchar r )
  Uchar j;
  Uchar i;
     WRCommandH (0x34);
                          //去扩展指令寄存器
     WRCommandH (0x36);
                          //打开绘图功能
     //两横的上边框 下边框
                              //2行
     for (j=0; j<2; j++)
        {
            WRCommandH(0x80+j); //Y总坐标,即第几行
            WRCommandH(0x80); //X坐标, 即横数第几个字节开始写起,80H为第一个字节
            for(i=0; i<8; i++) //写入一行
            WRDataH(x);
            WRDataH(x);
            WRCommandH(0x80+30+j); //Y总坐标,即第几行
            WRCommandH(0x80+8); //X坐标,即横数第几个字节开始写起,80H为第一个字
节
            for(i=0; i<8; i++) //写入一行
            {
            WRDataH(x);
            WRDataH(x);
           }
       //上半屏两横的右左边框
     for (j=2; j<32; j++)
                              //30行 左
        { //先上半屏
            WRCommandH(0x80+j); //Y总坐标,即第三行开始
            WRCommandH(0x80); //X坐标, 即横数第几个字节开始写起,80H为第一个字节
            WRDataH(1);
            WRDataH(0x00);
            WRCommandH(0x80+j); //Y总坐标,即第三行开始
            WRCommandH(0x80+7); //X坐标,即横数第几个字节开始写起,80H为第一个字
节
            WRDataH(0x00); WRDataH(r);
       //下半屏两横右左的边框
     for (j=0; j<30; j++)
                             //30行
        { //
            WRCommandH(0x80+j); //Y总坐标,即第一行开始
            WRCommandH(0x80+15); //X坐标,即横数第几个字节开始写起,80H为第一个字
```

```
WRDataH(0x00);
           WRDataH(r);
           WRCommandH(0x80+j); //Y总坐标,即第几行
           WRCommandH(0x80+8); //X坐标,即横数第几个字节开始写起,80H为第一个字
节
           WRDataH(1);
                             WRDataH(0x00);
//P3.2按键中断
void ini_int1(void)
EA=1;
EX0=1; // 允许外部INT0的中断
IT0=1;// 允许中断
int scankey1() interrupt 0 using 3 //使用外部中断1,寄存器组3
while (P3^2==0)
{for(;;)
{;}
  IE1=0;//中断标志清零
      //主函数
void main(void)
for (m1=0; m1<50; m1++)
      ini_int1();//开中断
      WaitNms (250);
      LCDInit();//初始化
      ShowNUMCharH(0x80,0x01,32);//显示半宽特殊符号
      ShowNUMCharH(0x90,0x30,32);//显示半宽0~?数字标点
      WaitNms (250);
                     //等待时间
                           ~~~~~~~~~1,显示8*16字符
      LCDInit();//初始化
      WRCommandH(0x01); //清除显示DDRAM
```

```
WRCGRAMH(0xff,0x00,0x40);//写入横(自编特殊符号)
WRCGRAMH(0x00,0xff,0x50)://写入横2
WRCGRAMH(0xaa, 0xaa, 0x60);//写入竖
WRCGRAMH (0x55, 0x55, 0x70); //写入竖2
ShowCGCharH(0x80,0x00);//显示横并填满
WaitNms (250); //等待时间
                     ~~~~~~~~2, 隔横显示
WRCommandH(0x01): //清除显示DDRAM
ShowCGCharH(0x80,02);//显示横2并填满
WaitNms(250); //等待时间
 WRCommandH(0x01); //清除显示DDRAM
ShowCGCharH(0x80,04);//显示竖并填满
WaitNms (250);
              //等待时间
~~~~~~~~4,隔列显示
WRCommandH(0x01); //清除显示DDRAM
ShowCGCharH(0x80,06);//显示竖2并填满
WaitNms(250);
              WRCommandH(0x01); //清除显示DDRAM
WRCGRAMH (0x00, 0x00, 0x40); //清CGRAM1 (重复使用自编)
WRCGRAMH (0x00, 0x00, 0x50); //清CGRAM2
WRCGRAMH(0xaa, 0x55, 0x40);//写入点(自编特殊符号)
WRCGRAMH (0x55, 0xaa, 0x50); //写入点2
ShowCGCharH(0x80,00);//显示点并填满
WaitNms (250);
  WRCommandH(0x01); //清除显示DDRAM
ShowCGCharH(0x80,02);//显示点2并填满
              //等待时间
WaitNms (250);
                  ~~~~~~~~~7,隔点显示
//显示汉字一屏
LCDInit();//初始化
ShowQQCharH(0x80, uctech, 16); //调用字库
ShowQQCharH(0x90, uctech3, 16);
CLEARGDRAMH(0x00); //清除显示绘图
WRGDRAM128X8(0,0,0xff);//单独一行反白
WaitNms (250);
```

```
LCDInit();//初始化
       ShowQQCharH(0x92,uctech1.4)://显示'绘晶科技'
       ShowQQCharH(0x8A, uctech2, 4);//显示' 128*64 '
       CLEARGDRAMH(0x00); //清除显示绘图
       WRGDRAM1 (0xff, 0xc0, 0x03);
                                  //绘图演示-画边框
       WaitNms (250);
      LCDInit();//初始化
       ShowQQCharH(0x80, uctech6, 16);//调用字库
       ShowQQCharH(0x90, uctech7, 16);
      CLEARGDRAMH (0xff); //
       WaitNms(250);
                                  ~~~~~9,显示图文混合
         ----- -以下老化测试99小时
   LCDInit();//初始化
   ShowQQCharH(0x80,uctech4,2);//调用字库
   ShowQQCharH(0x90, uctech9,8);//调用字库
   ShowQQCharH(0x88, uctech8,8);//调用字库
   ShowQQCharH(0x98, uctech5,8);//调用字库
   for (z=0; z<10; z++)
       WRCommandH(0x80+2);//写地址
       WRDataH(0x3a);
       WRDataH(0x30+z); //分10
       for (z1=0; z1<10; z1++)
          WRCommandH(0x80+3);//写地址
          WRDataH(0x30+z1); //分10
          WRDataH(0x3a);
          for (d=0; d<6; d++)
              for (d1=0; d1<10; d1++)
                 WRCommandH(0x80+4);//写地址
                 WRDataH(0x30+d); //分10
                 WRDataH(0x30+d1); //分01
//
                 WRCommandH (0x10);
                 for (s=0; s<6; s++)
```

```
WRCommandH(0x80+5);//写地址
        WRDataH(0x3a);
        WRDataH(0x30+s); //秒10
        for(s1=0;s1<10;s1++)
            WRCommandH (0x80+6); //写地址
            WRDataH(0x30+s1);
                                     //秒01
            WRDataH(0x3a);
            WaitNms(5);///延时 x ms
            WRCommandH(0x18);
            for (s10=0; s10<10; s10++)
                WaitNms(5);///延时 x ms
                for (s100=0; s100<10; s100++)
                WRCommandH(0x80+7);//写地址
                WRDataH(0x30+s10); //100MS
                WRDataH(0x30+s100); //10MS
                WaitNms(5);///延时 x ms
        }
}
```